

GaN FET (150V) : Innoscience製 INN150LA070A 概要解析レポート



パッケージ外観



GaN FETチップ写真

概要

近年、データセンター機器や通信機器、電気自動車(EV)などの48Vアプリケーション向けに、150V GaN FET (主要メーカー:ROHM、EPC、GaN Systems)の需要が増加しています。GaN FETに特化した中国の半導体メーカーであるInnoscienceは、2022年3月に150V GaN FETのラインナップを発表しています。

本レポートでは、そのInnoscienceから発表されている150V GaN FETについてパッケージ構造、素子部断面観察などの構造解析、Nexperia製 150V GaN FET(GAN7R0-150LBE)との比較を行っています。

製品仕様・特徴

型番:INN150LA070A $V_{dss}=150V$, $I_d=28A$, $R_{on}=5.6m\Omega$ 製品リリース日:2022年5月

- ・GaN-on-Silicon E-mode (ノーマリーオフ) HEMT
- ・アプリケーション:
モータードライバ、クラス D オーディオアンプ、48Vシステムの高周波DC-DCコンバータなど

レポート内容・結果概要(レポートの目次はP.2を参照)

概要解析レポート 価格: ¥150,000(税抜) 発注後1weekで納品

- ・パッケージ外観とデータシートの数値はNexperia製 150V GaN FET(GAN7R0-150LBE)と類似。チップサイズ、レイアウト、断面構造に類似点が確認されます。
- ・詳細は本レポートをご参照ください。

※ Nexperia 150V GaN FET GAN7R0-150LBE構造解析レポートは販売中です。
詳しくはエルテックまでお問い合わせください。

概要解析レポートからの抜粋

【目次】	Page
1 デバイスサマリー	
Table1-1:デバイスサマリー	...
2 パッケージ観察	...
3 X線観察	...
4 チップ観察	...
5 チップ断面観察	...
6 150V Innoscience GaN FETと Nexperia GaN FETとの比較	...